

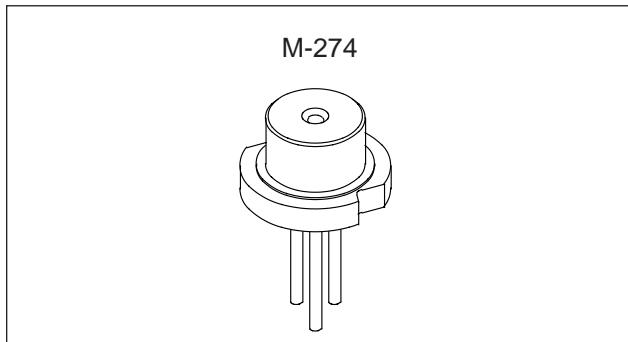
Index-Guided High Power AlGaAs Laser Diode

Description

The SLD231VL is a high-power, index-guided AlGaAs laser diode.

Features

- Low current consumption
- Small astigmatism
- Small package ($\phi 5.6\text{mm}$)



Applications

Pickup for optical discs

Structure

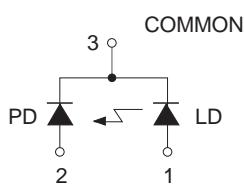
- AlGaAs quantum well structured laser diode
- PIN photodiode for optical power output monitor

Recommended Operating Optical Power Output 35mW

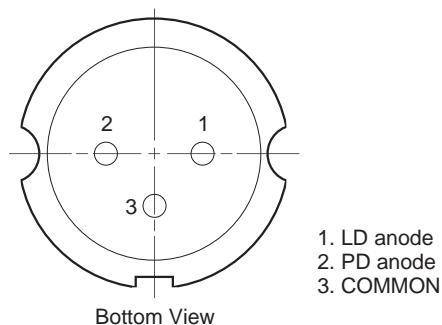
Absolute Maximum Ratings ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

• Optical power output	Po	40	mW	
• Reverse voltage	VR	LD	2	V
		PD	15	V
• Operating temperature	Topr	−10 to +60		°C
• Storage temperature	Tstg	−40 to +85		°C

Connection Diagram



Pin Configuration



Sony reserves the right to change products and specifications without prior notice. This information does not convey any license by any implication or otherwise under any patents or other right. Application circuits shown, if any, are typical examples illustrating the operation of the devices. Sony cannot assume responsibility for any problems arising out of the use of these circuits.

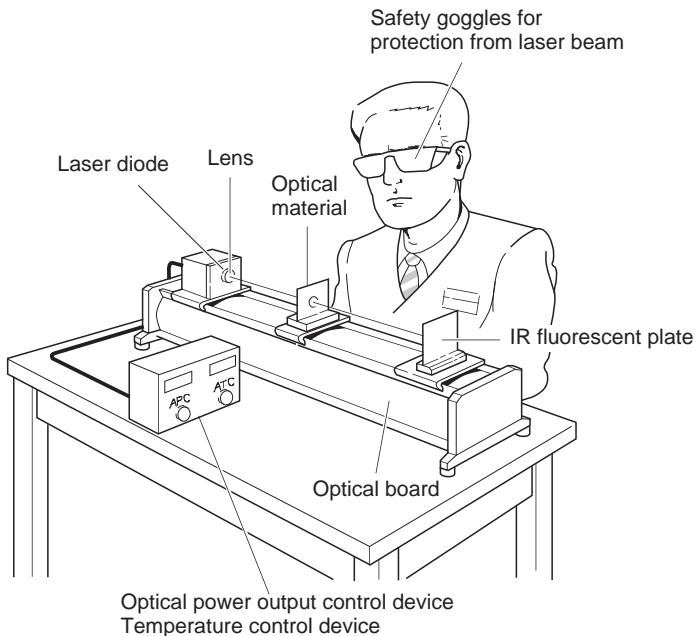
Optical and Electrical Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Tc: Case temperature

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit	
Threshold current	I_{th}		10	20	40	mA	
Operating current	I_{op}	$P_o = 35\text{mW}$	35	55	70	mA	
Operating voltage	V_{op}	$P_o = 35\text{mW}$	—	2.0	2.5	V	
Wavelength	λ	$P_o = 35\text{mW}$	780	790	800	nm	
Radiation angle	Perpendicular $\theta \perp$	$P_o = 35\text{mW}$	20	24	28	degree	
	Parallel $\theta //$		7	9	12	degree	
Positional accuracy	Position $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$	$P_o = 35\text{mW}$	—	—	± 80	μm	
	Angle $\Delta\phi \perp$		—	—	± 3	degree	
	$\Delta\phi //$		—	—	± 3	degree	
Differential efficiency	η_D	$P_o = 35\text{mW}$	0.7	1.0	1.3	mW/mA	
Astigmatism	A_s	$P_o = 35\text{mW}$	—	—	6	μm	
Monitor current	I_m	$P_o = 35\text{mW}, V_r = 5\text{V}$	—	0.10	—	mA	

Handling Precautions**(1) Eye protection against laser beams**

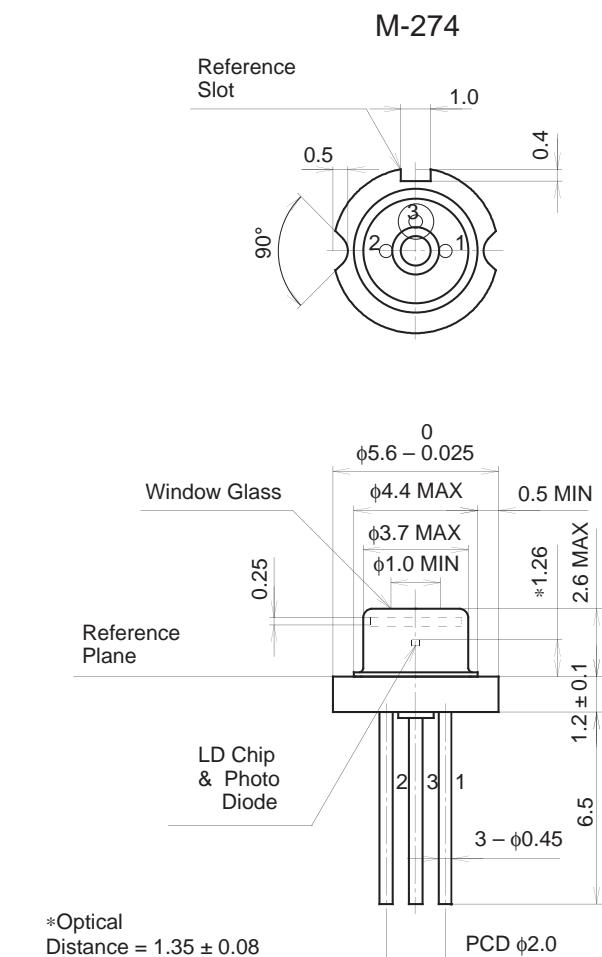
The optical output of laser diodes ranges from several mW to 4W. However the optical power density of the laser beam at the diode chip reaches $1\text{MW}/\text{cm}^2$. Unlike gas lasers, since laser diode beams are divergent, uncollimated laser diode beams are fairly safe at a laser diode. For observing laser beams, ALWAYS use safety goggles that block infrared rays. Usage of IR scopes, IR cameras and fluorescent plates is also recommended for monitoring laser beams safely.

**(2) Prevention of surge current and electrostatic discharge**

Laser diode is most sensitive to electrostatic discharge among semiconductors. When a large current is passed through the laser diode even for an extremely short time (in the order of nanosecond), the strong light emitted from the laser diode promotes deterioration and then laser diodes are destroyed. Therefore, note that the surge current should not flow the laser diode driving circuit from switches and others. Also, if the laser diode is handled carelessly, it may be destructed instantly because electrostatic discharge is easily applied by a human body. Be great careful about excess current and electrostatic discharge.

Package Outline

Unit: mm



SONY CODE	M-274
EIAJ CODE	_____
JEDEC CODE	_____

PACKAGE WEIGHT	0.3g
----------------	------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.